

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호

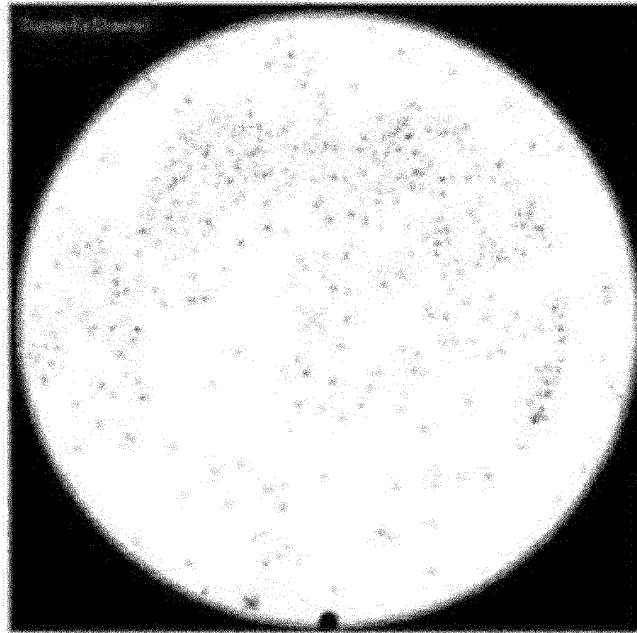
WO 2023/282475 A1

2023년 1월 12일 (12.01.2023) WIPO | PCT

- (51) 국제특허분류:
C09K 3/14 (2006.01) *B24B 37/10* (2012.01)
C09G 1/02 (2006.01) *H01L 21/306* (2006.01)
C09G 1/04 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/008078
- (22) 국제출원일: 2022년 6월 8일 (08.06.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2021-0089599 2021년 7월 8일 (08.07.2021) KR
- (71) 출원인: 영창케미칼 주식회사 (YOUNG CHANG CHEMICAL CO., LTD) [KR/KR]; 40046 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12, Gyeongsangbuk-do (KR).
- (72) 발명자: 김승환 (KIM, Seong Hwan); 42073 대구광역시 수성구 교학로11길 46, 112동 1301호, Daegu (KR). 이승훈 (LEE, Seung Hun); 42918 대구광역시 달성군 다사읍 죽곡1길 42, 103동 1805호, Daegu (KR). 이승현 (LEE, Seung Hyun); 42747 대구광역시 달서구 학산남로 90, 111동 1902호, Daegu (KR).
- (74) 대리인: 특허법인(유한) 해담 (HAEDAM IP GROUP); 06132 서울특별시 강남구 논현로 503, 송촌빌딩 1601호, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: SLURRY COMPOSITION FOR FINAL POLISHING OF SILICON WAFER FOR REDUCING NUMBER OF SURFACE DEFECTS AND HAZE AND FINAL POLISHING METHOD USING SAME

(54) 발명의 명칭: 표면 결함수 및 헤이즈 저감용 실리콘 웨이퍼 최종 연마용 슬러리 조성물 및 그를 이용한 최종 연마 방법



(57) Abstract: The present invention relates to: a slurry composition for final polishing of a silicon wafer, which reduces haze and the number of defects in the surface of an object to be polished and has excellent performance; and a final polishing method using same, the slurry composition comprising 1-20 wt% of colloidal silica as abrasive particles, 0.03-0.5 wt% of a surfactant, 0.1-10 wt% of a pH adjuster, 0.02-2 wt% of a water-soluble thickener, 0.05-0.2 wt% of a chelating agent, and 0.1-1 wt% of an organic base.

[다음 쪽 계속]



WO 2023/282475 A1

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역 내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(57) 요약서: 본원 발명은, 연마 입자로서 콜로이드실리카 1 내지 20 중량%, 계면활성제 0.03 내지 0.5 중량%, pH 조절제 0.1 내지 10 중량%, 수용성 증점제 0.02 내지 2 중량%, 킬레이트제 0.05 내지 0.2 중량%, 유기염기 0.1 내지 1 중량%로 이루어지는 연마 대상물 표면의 결함수를 저감시키고 헤이즈를 저감시키는 성능이 우수한 실리콘 웨이퍼 최종 연마용 슬러리 조성물 및 그를 이용한 최종 연마 방법에 관한 것이다. [대표도] 도 1